PAT-NO:

JP401073528A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01073528 A

TITLE:

SUBSTRATE FOR MAGNETIC DISK AND PRODUCTION THEREOF

PUBN-DATE:

March 17, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME KONDO, NAOTAKA NAKAMURA, SHUNICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

DENKI KAGAKU KOGYO KK

N/A

APPL-NO:

JP62229679

APPL-DATE:

September 16, 1987

INT-CL (IPC): G11B005/82, G11B005/704, G11B005/84

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve a sliding wear resistance characteristic (CSS resistance) by coating the surface of a metallic disk with a resin film provided with concentrical or spiral grooves.

CONSTITUTION: The surface of the metallic disk 1 is coated with the resin film 2 which is provided with the concentrical or spiral grooves having ≤10,000Å groove width, 100∼5,000Å groove depth and ≤10,000Å groove pitch and has ≥1μm thickness. The metallic disk 1 is formed by working a metal such as aluminum or alloy essentially consisting of aluminum to a disk shape. The substrate for the magnetic disk formed with the grooves having the uniform groove width, depth and pitch is, therefore, produced by the simple stage. The CSS resistance is thereby improved.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭64-73528

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和64年(1989)3月17日

G 11 B 5/82

5/704 5/84 7350—5D 7350—5D Z —7350—5D

ー5D 審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

❷発明の名称

磁気ディスク用基板およびその製造方法

②特 顧 昭62-229679

❷出 願 昭62(1987)9月16日

⑩発明者 近藤

直孝

東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社

電子材料研究所内

砂発 明 者 中村

俊 一

東京都町田市旭町3丁目5番1号 電気化学工業株式会社

電子材料研究所内

切出 願 人 電気化学工業株式会社

東京都千代田区有楽町1丁目4番1号

明 細 會

1. 発明の名称

磁気ディスク用基板およびその製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 溝幅10000A以下、溝の深さ100〜 5000A、溝ピッチ10000A以下の同心円 状もしくは過巻き状の溝を設けた厚さ1 μm 以上 の歯脂膜で金属円板の表面を被覆した磁気ディス ク用基板。

2. 紫外線硬化樹脂で被覆した金属円板に、同心円状もしくは過巻き状の溶を設けたガラス板を、金属円板の中心と同心円もしくは過巻きの中心を一致させて重ね、ガラス板の上から紫外線を開いたの間に樹脂に転写させることを特徴とする同心円状もしくは過巻き状の溶を設けた厚さ1 μπ 以上の樹脂膜で金属円板の表面を被覆した磁気ディスク用基板の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は金属薄膜磁性層を記録媒体とする耐 摺動摩耗特性(以下、耐 C88 性という)に優れた 磁気デイスク用基板およびその製造方法に関する ものである。

〔従来の技術〕

近年高密度記録媒体としてめつき法もしくはスパッタ法による金属薄膜媒体が使用化さればじめた。これら記録媒体を用いた磁気ディスクは、アルミニウム合金円板の上にNi-Pめつきを施して硬質化した基板の上に金属薄膜磁性層が被覆され、更にその上にカーポン等の保護膜が被覆されている。

高記録密度化のために磁気デイスクは磁気へッドの低浮上化における安定した磁気へッド浮上状態を確保する必要があり、基板の表面は適度の平滑性が要求される。基板の平滑性を確保するために、従来はアルミニウム合金円板上に施されたN1-Pめつき膜を鏡面に仕上げるいわゆるポリシュ加工が行なわれている。基板の表面が平滑になり過ぎると磁気デイスク表面も平滑になり過ぎ、

磁気ヘッドが磁気デイスクに吸着されて、磁気ヘッドと磁気デイスクとの耐 CSS 性が低下し、更に磁気ペッドおよび磁気デイスクが損傷(ヘッドクラッシュ)する。

これを防止するために、Ni-P めつき膜の表面 にテープ研磨法等により同心円状の溝を設けるい わゆるテクスチャリングが一般に行なわれている。 また、テクスチャリングをすることによつてその 上に被優される磁性体が円周方向に磁気配向し、 磁気配録・再生特性が向上するという効果もある。 〔発明が解決しようとする問題点〕

しかしながら、上配のようにアルミニウム合金 円板上にNi-Pめつきを施し、ポリシュ加工を行 ない、そしてテクスチャリングを行なつた磁気デ イスク用基板はテクスチャリングによる溝が不均 一であり、耐 CSS 性にパラッキが生じる。さらに、 磁気デイスク基板がポリッシュ加工、テクスチャ リングなど多くの工程で製造されるため製造があ 雑であり、基板が高価になるという問題があつた。 この発明は上配の問題を解決し、簡単な工程で

(3)

である。その表面は表面粗さ Ra が $0.01\sim0.02$ μ m 、 R_{max} が $0.1\sim0.3$ μ m ていどに、また、 9 ねりは $3\sim6$ μ m ていどに研摩仕上げをすることが好ましい。

紫外線硬化樹脂はポリメタクリル酸メチル、エポキシアクリレートなどである。磁気ディスクは耐 CSS 性が要求されるため樹脂膜の硬度を高くする必要があり、粒径100~1000Å、好ましくは200~500Åの SiO2 や A&2O3 等の硬質の微細粒子を前記樹脂に20~40重量 5 加えることが望ましい。

前記樹脂を金属円板に塗布する。塗布の方法はスピンコート法が望ましい。樹脂膜の厚さは硬化後で1 4m 以上でなければならず、好ましくは5~20 4m である。樹脂の膜の厚さが1 4m 未満では低気ヘッドの衝撃に耐える硬度を出すことができない。20 4m 以上の厚さのものを得ることは硬化に時間がかかるので生産性に問題がある。なか、紫外線硬化樹脂は硬化により縮むので硬化的の樹脂の被覆の厚みは硬化後の目標の厚さの数倍

耐 C88 性に優れた磁気デイスク用基板を提供する ことを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

本発明の第1は薄幅10000Å以下、溝の深さ100~5000Å、溝ピッチ10000Å以下の同心円状もしくは渦巻き状の溝を設けた厚さ1 am 以上の樹脂膜で金属円板の表面を被覆した磁気ディスク用基板である。

また、本発明の第2は紫外線硬化樹脂で被覆した金属円板に河心円状もしくは過巻き状の薄を設けたガラス板を、金属円板の中心と同心円もしくは過巻きの中心とを一致させて重ね、ガラス板の上から紫外線を照射して前記樹脂を硬化させるの 記ガラス板の溝を前記樹脂に転写させることを特徴とする河心円状もしくは過巻き状の溝を設けた厚さ1 mm以上の樹脂膜で金属円板の表面を被覆した磁気ディスク用基板の製造方法である。

以下、本発明を詳しく説明する。本発明におい 内 て金属暦板とはアルミニウム、アルミニウムを主 体とする合金などの金属を円板状に加工したもの

(4)

にしなければならない。

金属円板表面の樹脂膜に設けられた薄は幅が 10000Å以下でなければならず、好ましくは 1000Å以下である。溝幅が10000Åを超 えると所図の磁気特性および耐 CSS 性が悪化する。

また、前記簿は深さが100~5000 Å でなければならず、好ましくは300~1000 Å である。簿の深さが100 Å 未満では所望の磁気特性、耐 CSS 性を得ることは困難であり、また、5000 Å を越えると所望の磁気特性を得ることができない。

さらに、溝ピッチは 1 0 0 0 0 Å以下でなければならず、好ましくは 2 0 0 0 Å以下である。溝ピッチが 1 0 0 0 0 Åを越えると所望の磁気特性・耐 CSS 性を得ることができない。

溝を転写させるためのパターンを形成したガラス板を製作するには次の2通りの方法がある。第1には表面租度 Ra が 0.0 0 2 μm 以下の鏡面に仕上げたガラス板に集束イオンピーム装置によりイオンピームを照射することによつてガラス板表面

つぎに、同心円状または渦巻きの溝を設けたポ ラス板を前記樹脂膜で被覆した金属円板と重ねる。 この際、金属円板の中心とガラス板上の同心円ま たは渦巻きの中心とを一致させなければならない。 つぎに紫外線を照射する。紫外線の皮長は用いる

(7)

を前記の樹脂膜で被覆したアルミニウム円板と同心円の中心を一致させて重ね、ガラス板の上から紫外線灯で波長1600~2000Åの紫外線を15秒間照射した。その結果、樹脂膜2は硬化し、アルミニウム円板1の表面に同心円の多数の溝6が形成された。溝幅Aは500Å、溝の深さBは1000Å、溝ピッチでは1000Åであつた。樹脂膜の厚さは10々maであつた。

このようにして得られた磁気デイスク基板上にスパッタリング法で Co・Ni・Cr 合金薄膜磁性層と 炭素からなる保護膜を被覆して磁気デイスクとした。この磁気デイスクの耐 CSS 性試験を行なつた ところ、耐 CSS 回数は 3 万回以上であつた。

なお、耐 CSS 性試験は IBM - 337 ①タイプのヘッド(Mn-2n- フェライト製)を用い、ヘッド 荷重9.5 g、回転速度360 0 rpm、 ON - OFF サイクル30 秒で行ない、ヘッドクラッシュが発生するまでのサイクル数を測定した。

b) 寒施例 2

第3図に示すとおり、アルミニウム円板1の表

紫外線硬化樹脂の種類により定めればならないが一般には1600~2000Åが好ましい。 無射時間は紫外線の強度にもよるが通常は10~20秒が好ましい。紫外線の無射によって前記樹脂は硬化し、金属円板の表面に帯が形される。

〔寒施例〕

本発明の実施例を図面を用いて説明する。

a) 実施例1

第1図は本発明の磁気ディスク用基板の断面図である。まず、表面を鏡面仕上げしたアルミニウム円板1を準備した。ポリメタクリル酸メチルに対し粒径200~500Åのシリカを40重量が加えたものを前配円板に塗布して樹脂膜2とした。

いつぼり、第2図に示す表面租度 Ra が 0.002 дт 以下の銀面に仕上げたガラス板 3 に集束イオ ンピーム装置によりイオンピームを照射させ、ガ ラス板の表面に同心円の多数の溝 4 を形成させた。 スパッタリング装置により、その表面をフッ化マ グネシウム膜 5 で被覆した。

このようにして同心円状の溝を設けたガラス板

(8)

[発明の効果]

本発明によれば簡単な工程で清幅、溝の深さおよび溝ピッチが均一な溝を有する磁気ディスク用 基板を製造することができる。本発明の磁気ディスク スク用基板をもとに製造される磁気ディスクはと くに耐 CSS 性が均一で優れている。

4. 図面の簡単な説明

第1図および第3図は本発明の磁気デイスク用 基板の断面図である。第2図は本発明の磁気デイスク用基板の製造に用いられるガラス板の断面図 である。

符号 1 … アルミニウム円板、2 … 樹脂膜、3 … ガラス板、4 … 溝、5 … フッ化マグネシウム膜、6 … 溝、A … 溝幅、B … 溝の探さ、C … 溝ピッチ 一 特許 出願人 電気化学工業株式会社



